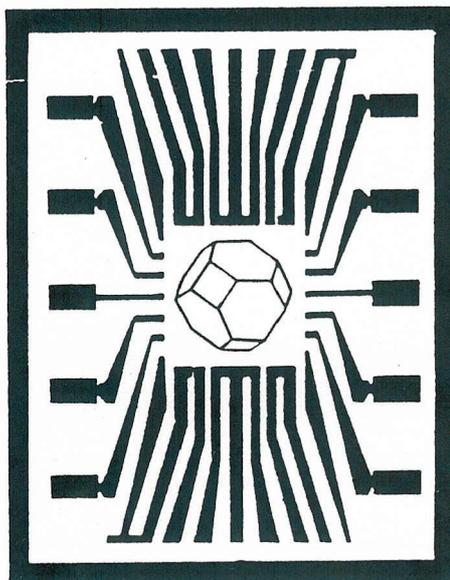




CENTRO INTERUNIVERSITARIO  
DI STRUTTURA DELLA MATERIA - MPI  
GRUPPO NAZIONALE  
DI STRUTTURA DELLA MATERIA - CNR

# SETTORE SEMICONDUTTORI

Convegno  
Scientifico Annuale  
1988



Parma 30 Novembre - 1/2 Dicembre 1988

Sede del Convegno:

Centro Congressi S. Elisabetta

Nuovo Insediamento Universitario - V.le delle Scienze

## PROGRAMMA

Mercoledì 30 Novembre 1988

### DISPOSITIVI E PROBLEMI CONNESSI SPETTROSCOPIA VELOCE NEI SEMICONDUTTORI

8.45-9.00 Apertura del Convegno

9.00-9.45 M. MALVEZZI  
Università di Pavia

*«Eccitazioni al picosecondo in silicio».*

9.45-10.30 P. BAERI  
Università di Catania

*«Transizioni di fase ultraveloci in silicio e silicio iperdrogato».*

10.30-11.00 L. ANGELONI\*, A. CHIARI\*\*, M.  
COLOCCI\*, F. FERMI\*\*, M. GURIOLI\*, R. QUERZOLI\*,  
A. VINATTIERI\*

\* Università di Firenze

\*\* Università di Parma

*«Luminescenza risolta temporalmente in strutture  
GaAs/GaAlAs eccitate con impulsi al picosecondo».*

11.00-11.30 Intervallo

11.30-12.30 G. FERLA  
SGS-Thomson Catania

*«Processi e dispositivi innovativi in microelettronica».*

12.30-13.00 M. GENTILI, A. LUCCHESINI  
IESS-CNR, Roma

*«Applicazioni della litografia a fascio elettronico nella realiz-  
zazione di dispositivi submicrometrici».*

13.00-14.30 Intervallo

14.30-15.00 L. REGGIANI  
Università di Modena

*«Fenomeni di generazione e ricombinazione da centri idroge-  
noidi in presenza di campi elettrici».*

15.00-15.30 F. NAVA  
Università di Modena

*«Processi termici rapidi».*

15.30-16.00 G. FORTUNATO, L. MARIUCCI, C. REITA  
IESS-CNR, Roma

*«Transistors a film sottile di silicio amorfo idrogenato».*